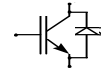


Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

BSM15GD120DLC E3224

eupec



Thermische Eigenschaften / Thermal properties

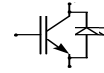
			min.	typ.	max.	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Transistor / transistor, DC	R_{thJC}	-	-	0,86	K/W
	Diode/Diode, DC		-	-	1,50	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module $\lambda_{Paste} = 1 \text{ W/m} \cdot \text{K} / \lambda_{grease} = 1 \text{ W/m} \cdot \text{K}$	R_{thCK}	-	0,02	-	K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		T_{vj}	-	-	150	°C
Betriebstemperatur operation temperature		T_{op}	-40	-	125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40	-	150	°C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix					
Innere Isolation internal insulation				AL ₂ O ₃	
CTI comperative tracking index				225	
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque	terminals M5	M1	3	6	Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse terminal connection torque		M2			Nm
Gewicht weight		G		180	g

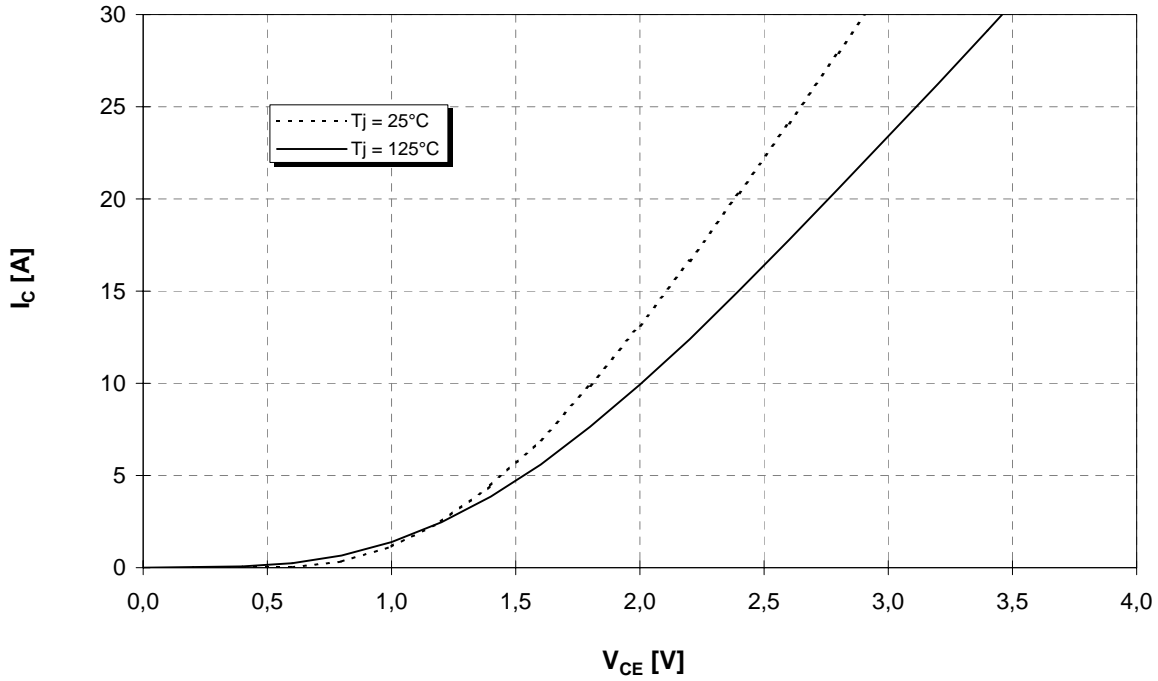
Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.



Ausgangskennlinie (typisch)
Output characteristic (typical)

$I_c = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15V$



Ausgangskennlinienfeld (typisch)
Output characteristic (typical)

$I_c = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 125°C$

